

基本信息



姓名：小泉英明
 性别：男
 出生日期：1946年10月

当选信息：
 2011年 中国工程院
 所属学部：
 中国工程院
 日本工程院

院士简介

小泉英明，男，出生于1946年10月，日本工程院院士，日本学术振兴学会会员，日本工程院外事委员会主任。

小泉博士长期从事电子学和成像技术前沿研究，成绩突出，在国际光谱、核磁成像和近红外成像上是国际著名的学者，曾获得诺贝尔奖提名。已注册专利超过163项（日本74项，海外89项），其中50项被日本通产省提名为日本突出专利。

小泉博士多次获得日本的国家级奖励。

2011年当选为中国工程院外籍院士。

主要学历

1967年 - 1971年 日本东京大学 基础科学系 硕士
 1971年 - 1976年 日本东京大学 物理学专业 博士

主要经历

1971年 - 2017年 日本日立制作所 副研究员、研究员
 1992年 日本日立制作所中央研究实验室医疗电子研究部 首席科学家
 1999年 - 2001年 日本日立制作所高级研究实验室 总经理
 2003年 日本日立制作所 首席科学家
 2004年 - 2017年 日本日立制作所 研究员
 2015年 日本工程院 执行副院长

2017年 日本日立制作所 名誉研究员、独立理事

2019年 日本东京大学高级科学技术研究中心 研究员

本资料由中国工程院院士馆提供

